

	<p>SI5509DC-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI5509DC-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 20V 6.1A 1206-8</p> <p>Datenblätter:  SI5509DC-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI5509DC-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 20V 6.1A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	52 mOhm @ 5A, 4.5V
Leistung - max	4.5W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	455pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.6nC @ 5V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 20V 6.1A, 4.8A 4.5W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.1A, 4.8A
Basisteilenummer	SI5509

SI5509DC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5509DC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5509DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5509DC-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5511DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 30V 4A 1206-8</p>	 <p>SI5504DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 30V 2.9A 1206-8</p>	 <p>SI5511DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 30V 4A 1206-8</p>	 <p>SI5509DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 6.1A 1206-8</p>
 <p>SI5511DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 30V 4A 1206-8</p>	 <p>SI5504DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 30V 2.9A 1206-8</p>	 <p>SI5511DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 30V 4A 1206-8</p>	 <p>SI5509DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 6.1A 1206-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI5509DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5509DC-T1-GE3 Datenblatt	SI5509DC-T1-GE3-Datenblätter	SI5509DC-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5509DC-T1-GE3
SI5509DC-T1-GE3 Electronic	SI5509DC-T1-GE3-Komponenten	SI5509DC-T1-GE3-Verteiler	SI5509DC-T1-GE3-Bild	SI5509DC-T1-GE3-Teil
SI5509DC-T1-GE3 Preis	SI5509DC-T1-GE3 Hersteller	SI5509DC-T1-GE3 Bild	SI5509DC-T1-GE3 Aktie	SI5509DC-T1-GE3 Inventar
SI5509DC-T1-GE3 Neu	SI5509DC-T1-GE3 Original	SI5509DC-T1-GE3 garantiert	SI5509DC-T1-GE3 RFQ	SI5509DC-T1-GE3 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited